

СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ

по диссертации Рахматова Бадурдина Амируллоевича на тему «Разработка «внешней» компактной модели органического полевого транзистора с учетом дифференциальной проводимости» на соискание ученой степени кандидата физ.-мат. по специальности 1.3.8.-физика конденсированного состояния.

Фамилия, имя, отчество	Попов Виктор Дмитриевич
Гражданство	Россия
Ученая степень	доктор технических наук, 05.27.01
Ученое звание	профессор
Основное место работы	
Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Наименование подразделения	Институт нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике. Кафедра «Микро- и наноэлектроники»
Должность	Профессор
Почтовый адрес	115409, Москва, Каширское шоссе, д.31.
Электронная почта, телефон	wpopov@mail.ru . Моб.т. 8 909 679 87 85

Список публикаций

1. Куликов Н.А., Попов В.Д., Фелицын В.А. Радиационная чувствительность р-канальных МОП-транзисторов при дозиметрии гамма-излучения и рентгеновских лучей.- Датчики и системы. №5(236). 2019. С.20-23.
2. Кулаков С.Н., Куликов Н.А., Матешева В.В., Попов В.Д. Исследование КМОП ИМС при низкоинтенсивном гамма-излучении.- Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. Вып.1-Лыткарино: ФГУП «НИИП», 2019. С.5-7.
3. Петросянц К.О., Харитонов И.А., Попов В.Д., Куликов Н.А.. Учет эффектов малой мощности дозы при моделировании работы МОП схем. Доклад на конференции «Спецстойкая микроэлектроника 2019» (11-12 апреля 2019, (Нижегородская область, поселок Жёлнино).
4. Petukhov K A and Popov V D. Effect of the active mode NMOS-transistor irradiated on formation of surface defects. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Published under licence by IOP Publishing Ltd), 2019 ,Vol.498, Number 1, P.012016.
5. Куликов Н.А., Попов В.Д. Влияние электрического режима и гамма-облучения на образование поверхностных дефектов на границе раздела Si-SiO₂ в МОП транзисторе. – Физика и техника полупроводников. 2019. Том.53. №1. С.115-118. (Kulikov N.A., Popov V.D. Influence of the Electric Mode and γ Irradiation on Surface-Defect Formation at the Si-SiO₂ Interface in a MOS Transistor. – Semiconductor. 2019. Vol.53. No 1. P.110-113).
6. Куликов Н.А., Попов В.Д. Исследование процесса старения МОП-транзисторов с n-каналом, Вопросы атомной науки и техники. Серия: физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. 2018. №3. С. 27-30.

7. Куликов Н.А., Попов В.Д., Чубунов П.А. . Прогнозирование вероятности безотказной работы микроконтроллера на геостационарной орбите. – Космические исследования. 2018. Том 56. №5. (Kulikov N.A, Popov V.D., Chubunov P.A. Predicting the No-Failure Microcontroller Operation Probability in a Geostationary Orbit. – Cosmic Research. 2018. Vol.56. No 5. P.400-404).
8. Петухов К.А., Попов В.Д. Исследование поверхностного дефектообразования в МОП-транзисторе с p -каналом при длительном воздействии гамма-излучения. – Датчики и системы. №2.2018. С.53-56.
9. Попов В.Д. Образование дефектов поверхности КМОП-структур при облучении гамма-лучами и при повышенной температуре.- Известия вузов – ЭЛЕКТРОНИКА. 2017. Том 22. №5. С.491-493
10. Popov V.D. Investigation of the surface defects in n-channel MOS transistors under long-term low-dose-rate irradiation.- Journal of Materials Science Research. Vol.6. No 2. 2017. P.16-19.
11. Петухов К.А., Попов В.Д. Влияние электрического режима на образование поверхностных дефектов МОП-транзисторе при длительном низкоинтенсивном воздействии гамма-излучения. - Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. Вып.1- Лыткарино: ФГУП «НИИП», 2017. С.22-25.
12. Власов Р.В., Паршакова Е.С., Попов В.Д. Исследование изменения плотности поверхностных дефектов при длительном низкоинтенсивном облучении КМОП ИМС зарубежного производства. - Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. Вып.1- Лыткарино: ФГУП «НИИП», 2016. С.19-21.
13. Орешков П.Н., Попов В.Д. Прогнозирование вероятности отказа flash-памяти при низкоинтенсивном облучении.- Датчики и системы. №4. 2016. С.61-63.
14. Попов В.Д. Два этапа поверхностного дефектообразования в МОП структуре при низкоинтенсивном воздействии гамма-излучения.- Физика и техника полупроводников. 2016. Том 50. Вып.3. С.354-356.(Popov V.D. Two stages of surface-defects formation in a MOS structure under low-dose rate gamma irradiation.- Semiconductors.2016 - 50(3). P.349-351).
15. Correction of In-Flyght Dose Sensors Measurements Results in a Middle-Earth Orbit Taking the Fading Effect into Account / V.S.Anashin, G/A/Protopopov, O.S.Kozyukova, I.A.Lyakhov, S.V.Balashov, N.N.Sitnikova, S.V.Tasenko, P.V.Shatov, V.D.Popov// 15th European Conference on Radiation and Its Effects on Components and Systems (RADECS). – Moscow, Russia, 14-18 September 2015. P.182-186.
16. Analysis Results of In-Flight Measurements in Geostationary and Polar Orbits in 2014-2015. / V.S.Anashin, G/A/Protopopov, P.V.Shatov, S.V.Tasenko, V.D.Popov, O.S.Kozyukova, I.A.Lyakhov// 15th European Conference on Radiation and Its Effects on Components and Systems (RADECS).–Moscow, Russia,14-18 September 2015. P.388-390.
17. Власов Р.В., Попов В.Д. Изменение параметров МОП-транзисторов при низкоинтенсивном облучении.- Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. Вып.4.- Лыткарино: ФГУП «НИИП», 2015. С.43-46.
18. Орешков П.Н., Попов В.Д. Модель влияния ионизирующего излучения и температуры на характеристики МОП-транзистора.- Датчики и системы. 2015. №1. С.57-60.

Попов Виктор Дмитриевич, д.т.н., профессор



Подпись удостоверена
Заместитель начальника отдела
документационного обеспечения
НИИЯУ МИФИ

В. М. Самодурова